



1. อันตรกริยาของรังสีแกมมา กับ สสาร

สสารที่มีอันตรกริยาที่ปล่อยรังสีแกมมา เมื่อไปปะทะกับสสารจะเกิดอันตรกริยาแบบต่าง ๆ ซึ่งแล้วแต่ขนาดของพลังงานรังสีแกมมา และชนิดของสสารอันตรกริยาแบ่งได้เป็น 3 พวกใหญ่⁽¹⁾ คือ

1.1 ปฏิกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก (photoelectric effect) เป็นขบวนการที่โฟตอนเกิดอันตรกริยากับอะตอมของวัตถุนั้น ๆ โดยถ่ายเทพลังงานให้แก่อิเล็กตรอนในเชลล์ (shell) ใดเชลล์หนึ่งจนหมด แล้วอิเล็กตรอนตัวนั้นก็หลุดออกจากวงจรร โดยพลังงานจลน์เท่ากับพลังงานของรังสีแกมมานั้นลบด้วยพลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy) ของเชลล์ที่อิเล็กตรอนตัวนั้นอยู่ และเมื่ออิเล็กตรอนในเชลล์หนึ่งหลุดออกไป อิเล็กตรอนที่อยู่ในเชลล์ถัดไปก็จะเคลื่อนเข้าแทนที่ต่อ ๆ กัน

1.2 ปฏิกิริยาแบบคอมพัตตัน (Compton scattering) ขบวนการนี้เหมือนกับกระชกของลูกบิลเลียด คือ โฟตอนเกิดอันตรกริยากับอิเล็กตรอนอิสระที่อยู่ในวัตถุนั้น โดยเกิดการชน แล้วถ่ายเทพลังงานให้อิเล็กตรอนไม่หมด นั่นคือ พลังงานส่วนหนึ่งจะถูกถ่ายเทให้อิเล็กตรอนตัวที่ถูกชนนั้นกระเด็นออกไป และพลังงานส่วนที่เหลือก็จะเป็นโฟตอนที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าเดิม พร้อมทั้งทิศทางก็เปลี่ยนไปจากเดิม

1.3 ปฏิกิริยาแบบอิเล็กตรอนคู่ (pair production) ขบวนการนี้เกิดขึ้นในบริเวณสนามคูลอมบ์ (Coulomb field) ของนิวเคลียส เมื่อรังสีแกมมาผ่านเข้าไปใกล้นิวเคลียสใด จะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง คือ รังสีแกมมานั้นหายไปแล้วเกิดอิเล็กตรอนและโพสิตรอนขึ้นมาแทนคู่หนึ่ง โดยพลังงานของรังสีแกมมานั้นกลายเป็นพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนและโพสิตรอนบวกกับมวลขณะหยุดนิ่ง (rest energy) ของอนุภาคทั้งสองนี้ สำหรับโพสิตรอนที่เกิดขึ้นเมื่อวิ่งไปก็จะสูญเสียพลังงานทำให้ตัวเองวิ่งช้าลง ๆ จนในที่สุดเมื่อพบกับอิเล็กตรอนก็จะรวมกันหายตัวไปทั้งคู่

กลายเป็นโฟตอนสองตัววิ่งออกจากกันในทิศทางตรงข้าม โดยแต่ละตัวมีพลังงานเท่ากันคือ 0.51 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่า เกิดการประลัย (annihilation) ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าปฏิกิริยาแบบอิเล็กตรอนคู่ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรังสีแกมมามีพลังงานมากกว่า 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์

2. อันตรกิริยาของรังสีแกมมาที่มีต่อโซเดียมไอโอดด์(ทาลเซียม)

ปรากฏว่าที่พลังงานต่ำ ๆ จะเกิดปฏิกิริยาแบบโฟโตอิเล็กตริก เป็นส่วนใหญ่ และที่พลังงานสูงขึ้นมาจะเกิดปฏิกิริยาแบบคอมป์ตัน ถ้าพลังงานรังสีแกมมาสูงเกินกว่า 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เกิดปฏิกิริยาแบบอิเล็กตรอนคู่ จากปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดอิเล็กตรอนขึ้นทั้งนั้น อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะไปกระตุ้น (excite) อะตอมของโซเดียมไอโอดด์(ทาลเซียม) ตามทางที่ผ่านไป อะตอมต่าง ๆ เหล่านี้ จะคายพลังงานออกมาในรูปของโฟตอน เพื่อ มาอยู่ในสถานะปกติ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ขบวนการ การเกิดสถานะโลด (excitation process) หรืออิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไปทำให้อะตอมของโซเดียมไอโอดด์ (ทาลเซียม) เกิดแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า (ionize) โดยทำให้อิเล็กตรอนที่วนอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสของโซเดียมไอโอดด์ (ทาลเซียม) หลุดออกไปทำให้เกิดที่ว่างขึ้น อิเล็กตรอนตัวใหม่จะถูกสับเข้ามาแทนที่ เกิดการส่งผ่านประจุ (charge transfer) ทำให้เกิดการลดพลังงานศักย์ (potential energy) พลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปโฟตอนเช่นกัน เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าขบวนการ การเกิดไอออน (ionization process) พลังงานในรูปของโฟตอนจาก 2 ปรากฏการณ์นี้จะถูกส่งผ่านไปยังทาลเซียม ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวให้เกิดแสง จะทำให้อะตอมของทาลเซียมได้รับการกระตุ้น แล้วคายพลังงานออกมาในรูปของแสงสีน้ำเงินที่มองเห็นได้ (visible blue photons) ซึ่งแสงเหล่านี้จะไปกระทบแผ่นโฟโตคะโทด (photocathode) ซึ่งอยู่ระหว่างผลึกโซเดียมไอโอดด์ (ทาลเซียม) กับ หลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (photomultiplier tube) โฟโตคะโทดทำด้วยโลหะผลักระหว่างแคดเมียม กับ แอนติโมนี มีเวริคฟังก์ชัน (work function) ต่ำ เมื่อแสงไปตกกระทบ จะให้อิเล็กตรอนออกมาเป็นปริมาณโดยตรงกับความเข้มของแสง อิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกขยายภายในหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ โดยการเคลื่อนที่จากไดโนด (dynode) หนึ่งไปยังอีกไดโนดหนึ่ง ซึ่งมีความต่างศักย์สูงกว่าอันแรก ความต่างศักย์ที่ใช้กับหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ ได้มาจากไฟฟ้าศักย์สูง (high voltage supply) ผลที่สุด

อิเล็กตรอนทั้งหมด จะเคลื่อนที่ไปที่ อะโนด (anode) ซึ่งเป็นขั้วลบ จะได้สัญญาณซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานที่ตกกลับภายในผลึกโซเดียมไอโอไดด์ ออกมาทางเอาต์พุต (output) แล้วเข้าวงจรขยายต่อไป

วงจรขยายสัญญาณมี 2 ระบบ คือ พร็แอมพลิฟิเออร์ (pre-amplifier) กับ เมน แอมพลิฟิเออร์ (main amplifier)

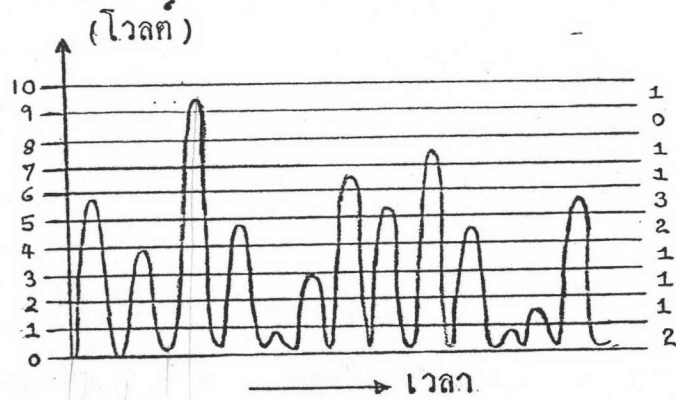
2.1 พร็แอมพลิฟิเออร์ คุณสมบัติของพร็แอมพลิฟิเออร์ คือต้องมีสิ่งรบกวน (noise) ต่ำมากและมีกำลังขยาย (gain) ไม่ลู่งักทหน้าที่เป็น แมทซิง (matching) หรือเป็นบัฟเฟอร์ (buffer) เพื่อปรับคุณภาพทางวงจรไฟฟ้า ของหัววัดรังสีให้เข้ากับ เมน แอมพลิฟิเออร์ปกติแล้ว พร็แอมพลิฟิเออร์จะอยู่ใกล้กับหัววัดรังสี

2.2 เมนแอมพลิฟิเออร์ เป็นระบบที่ขยายสัญญาณให้ได้ขนาดพอเหมาะที่จะทำให้นับสัญญาณได้ คุณสมบัติคือ กำลังขยายสูง โดยมีความคงที่แน่นอนของกำลังขยายที่มีต่อขนาดของสัญญาณที่จะทำการขยายอย่างเชิงเส้นสูง พร้อมทั้งปรับปรุงรูปร่าง (shaping) ของสัญญาณให้เหมาะสม

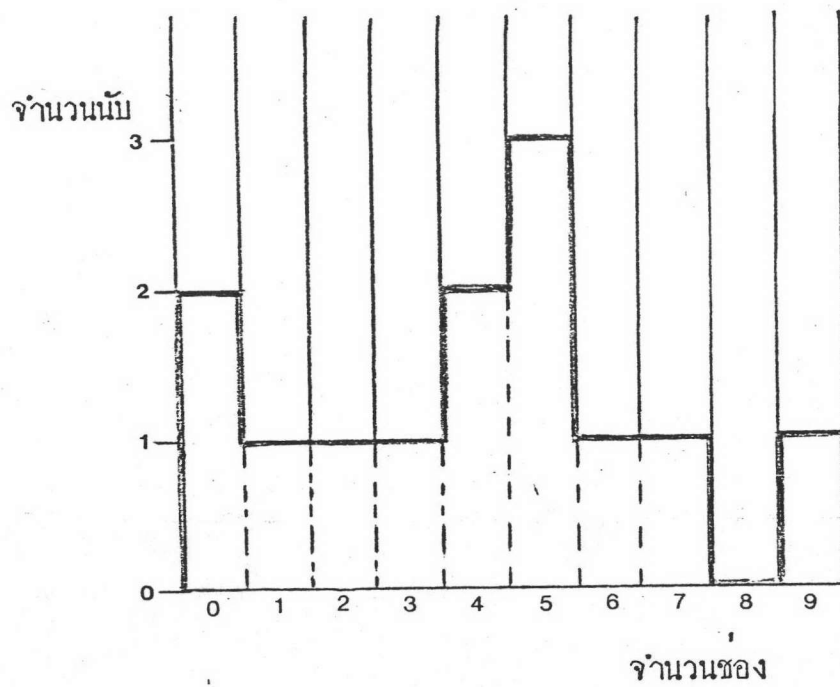
3. การวิเคราะห์สัญญาณของเครื่องวิเคราะห์หลายช่อง

หลักการวิเคราะห์ความสูงของสัญญาณ⁽²⁾ เมื่อสัญญาณจากชุดหัววัดรังสีป้อนผ่านวงจรขยายสัญญาณ จะได้สัญญาณที่มีขนาดความสูงเป็นสัดส่วนกับพลังงานของรังสีที่เข้ามาและถูกดูดกลืนโดยหัววัด วิธีการนับจำนวนสัญญาณ โดยการใช่วิธีคัดเลือกความสูงที่อยู่ในช่วงขนาดเดียวกันให้ับรวมกัน เรียกว่า ช่อง (channel) ถ้าแบ่งจำนวนช่องนี้เป็นช่องเล็ก ๆ ก็สามารถวิเคราะห์ความสูงของสัญญาณได้ละเอียดขึ้นตัวอย่างเช่น สมมติให้มีสัญญาณพัลส์ที่เข้ามาโดยมีขนาดความสูงของพัลส์ตั้งแต่ 0 ถึง 10 โวลต์ และถ้าแบ่งความสูงของสัญญาณนี้ โดยแบ่งจาก 10 โวลต์ เป็นจำนวนช่อง 10 ช่อง เมื่อจำนวนพัลส์ที่มามีขนาดดังในรูปที่ 2.1 ก. ให้ับจำนวนพัลส์ที่มีความสูงอยู่ในช่องเดียวกันเข้าด้วยกันเช่นช่องที่ 5 นับพัลส์ที่มีความสูงเท่ากับหรือมากกว่า 5 โวลต์ แต่ต้องน้อยกว่า 6 โวลต์ ซึ่งจะมีจำนวน 3 พัลส์ แล้วนำค่าที่ได้ต่าง ๆ นี้ไปเขียนกราฟ โดยให้แกนแนวนอนแบ่งออกเป็น 10 ช่อง ซึ่งตรงกับจำนวนช่องที่ความสูงของสัญญาณอยู่ ส่วนในแกนแนวตั้งแทนจำนวนนับของจำนวนพัลส์

ความสูงของสัญญาณ.



รูปที่ 2.1 ก. แสดงภาพของสัญญาณก่อนวิเคราะห์



รูปที่ 2.1 ข. แสดงกราฟหลังจากวิเคราะห์สัญญาณแล้ว

ที่มีความสูงอยู่ในช่องเดียวกัน ดังแสดงในรูป 2.1 ข.

ความละเอียดของการวิเคราะห์สเปกตรัมขึ้นอยู่กับจำนวนช่อง เช่น ที่ขนาดความสูงของสัญญาณจาก 0 ถึง 10 โวลต์ อาจแบ่งเป็น $2^9 = 512$ ช่อง หรือ $2^{10} = 1024$ ช่อง การแบ่งช่องมากขึ้นจะได้รายละเอียดมากขึ้น แต่ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของหัววัดรังสีที่จะสามารถแยกแยะระดับพลังงานของรังสี (resolution) ด้วย

3.1 ส่วนประกอบของเครื่องวิเคราะห์หลายช่อง^(2,3) โดยทั่วไปเครื่องวิเคราะห์หลายช่องจะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ชุดเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล ชุดหน่วยความจำ และ ชุดแสดงผล

3.1.1 ชุดเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล การทำงานของชุดเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล คือ จะเปลี่ยนขนาดความสูงของสัญญาณอนาลอกที่เข้ามาเป็นรหัสไบนารี ซึ่งเป็นสัญญาณดิจิทัล รหัสไบนารีนี้เป็นรหัสที่ใช้กำหนดแอดเดรสของหน่วยความจำ

วิธีการเปลี่ยนขนาดความสูงของสัญญาณอนาลอกเป็นรหัสไบนารีมีหลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ การให้ตัวเก็บประจุมีอัตราการคายประจุในลักษณะเชิงเส้น วิธีการนี้ เริ่มจากสัญญาณอนาลอกเข้าไปประจุที่ตัวเก็บประจุจนถึงแรงดันสูงสุด ตัวกำเนิดสัญญาณจะผลิตสัญญาณนาฬิกาที่อยู่ที่วงจรมับ ขณะที่ตัวเก็บประจุเริ่มคายประจุผ่านชุดจ่ายกระแสคงที่ จะมีสัญญาณไปควบคุมให้วงจรมับเริ่มนับ และจะหยุดนับเมื่อการคายประจุเสร็จสิ้นลง รหัสไบนารีที่วงจรมับนับได้นี้จะเป็นสัดส่วนกับความสูงของสัญญาณอนาลอก

3.1.2 ชุดหน่วยความจำ สัญญาณอนาลอกเมื่อถูกวิเคราะห์แล้วข้อมูลจะถูกเก็บในหน่วยความจำ วิธีการเก็บข้อมูลคือ เมื่อสัญญาณอนาลอกถูกเปลี่ยนเป็นรหัสไบนารีแล้ว รหัสไบนารีนี้จะไปที่แอดเดรสของหน่วยความจำ แล้วหน่วยความจำจะอ่านข้อมูลในตำแหน่งแอดเดรสนี้ออกมาให้แก่หน่วยนับ หน่วยนับจะบวกจำนวนนับเข้าไปอีกหนึ่ง แล้วป้อนให้หน่วยความจำเข้าไปเก็บยังตำแหน่งเดิม จะเห็นว่าหน่วยความจำจะเก็บข้อมูลเป็นจำนวนครั้งที่สัญญาณเข้ามา โดยที่แอดเดรสของหน่วยความจำจะเป็นสัดส่วนกับความสูงของสัญญาณอนาลอก

3.2 วิธีวิเคราะห์สัญญาณของเครื่องวิเคราะห์หลายช่อง⁽³⁾ เมื่อมีสัญญาณอนาลอกเข้ามายังชุดเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลรหัสไบนารี โดยข้อมูล

รหัสไลบรารีจะเป็นสัดส่วนกับขนาดความสูงของฟิล์ม สำหรับข้อมูลรหัสไลบรารี ใช้เป็นแอดเดรสของหน่วยความจำ ในที่สุด ข้อมูลในชุดหน่วยความจำ จะถูกบวกเพิ่มอีกหนึ่งเข้าไป ตัวอย่างเช่น สมมติให้สัญญาณอนาล็อกมีขนาดแรงดัน 2.5 โวลต์ เมื่อถูกชุดเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล เปลี่ยนเป็นจำนวนช่องที่ 137 ถ้าให้ข้อมูลของหน่วยความจำที่แอดเดรส 137 มีค่า 514 เมื่อมีการบวกหนึ่งจะได้ 515 แล้วป้อนกลับไปเก็บที่เดิม

4. ตัวเก็บประจุ

ในวงจรใด ๆ ที่มีแต่ตัวต้านทาน กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนั้นจะมีค่าคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา แต่ถ้าในวงจรมีทั้งตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรในขณะใด ๆ จะมีค่าไม่คงที่ โดยจะขึ้นอยู่กับเวลา ตามรูปที่ 2.2 แสดงถึงวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน R และตัวเก็บประจุ C

เมื่อสับสวิตช์มาที่จุด a กระแสไฟฟ้าจะไหลในวงจร สมมติว่าในเวลา dt จำนวนประจุที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดใด ๆ ในวงจรเท่ากับ dq ดังนั้น งานที่แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระทำได้คือ $E dq$ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับงานที่เกิดขึ้นแก่ตัวต้านทาน R และ ตัวเก็บประจุ C ในเวลา dt พลังงานที่เกิดขึ้นกับตัวต้านทาน R ในรูปของความร้อนคือ $i^2 R dt$ และพลังงานที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุในรูปของสนามไฟฟ้าคือ

$$dU = d\left(\frac{q^2}{2C}\right) \quad (2.1)$$

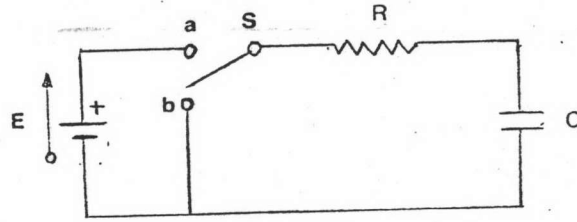
จากหลักพลังงานคงตัว จะได้

$$E dq = i^2 R dt + d\left(\frac{q^2}{2C}\right) \quad (2.2)$$

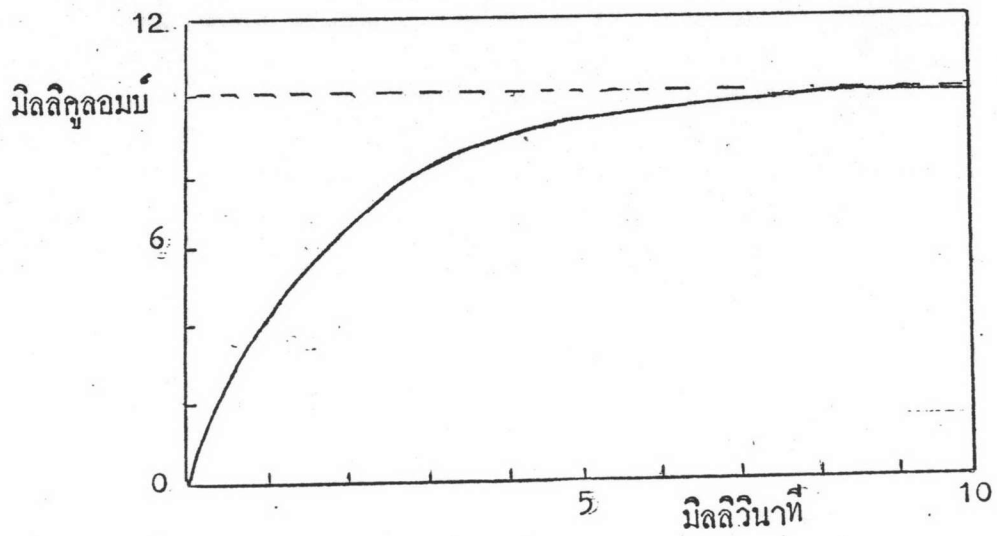
$$\text{จะได้} \quad E - iR - \frac{q}{C} = 0 \quad (2.3)$$

จากสมการ (2.3) จะคำนวณหาจำนวนประจุ q ที่เก็บสะสมไว้ในตัวเก็บประจุในเวลาใด ๆ คือ

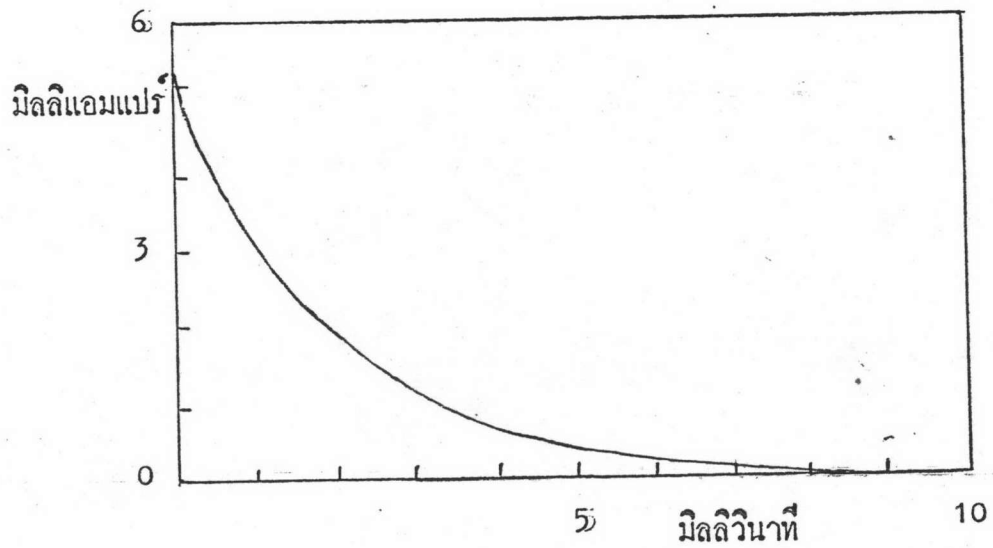
$$E - \frac{dq}{dt} R - \frac{q}{C} = 0 \quad (2.4)$$



รูปที่ 2.2 แสดงภาพวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ



รูปที่ 2.3 ก. แสดงการประจุของตัวเก็บประจุ



รูปที่ 2.3 ข. แสดงการไหลของกระแสขณะตัวเก็บประจุกำลังประจุ

จะได้ $\ln(EC - q) = -\frac{t}{RC} + \text{const}$ (2.5)

เมื่อ $t = 0$ และ $q = 0$ ดังนั้นสมการ (2.5) จะเป็น

$$\ln EC = \text{const} \quad (2.6)$$

แทนค่า const ในสมการ (2.5) จะได้

$$\ln(EC - q) = -\frac{t}{RC} + \ln EC$$

หรือ $\ln \frac{EC - q}{EC} = -\frac{t}{RC}$

นั่นคือ $q = EC(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ (2.7)

สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรในเวลาใด ๆ หาได้จาก

$$i = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

จากสมการที่ (2.7) และ (2.8) เมื่อ $t = 0$ และ $q = 0$ เริ่มแรกกระแสจะมีค่าสูงสุด แต่เมื่อ $t = \infty$, $q = EC$ และ $i = 0$ แสดงว่าเมื่อ ตัวเก็บประจุ มีประจุเต็ม จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร จากสมการ (2.7) และ (2.8) แสดงได้ตามกราฟในรูปที่ 2.3 ก. และ 2.3 ข.

จากสมการ (2.7) เมื่อ $t = RC$

$$q = EC(1 - e^{-1})$$

หรือ $q = 63\%$ ของ EC (2.9)

เมื่อประจุ q_0 บนตัวเก็บประจุ มีค่าสูงสุดเท่ากับ EC เมื่อสลับวิตช์มาอย่างตำแหน่ง b ตัวประจุจะเริ่มออกจากตัวเก็บประจุ ผ่านตัวต้านทาน R จะคำนวณหาจำนวนประจุที่มีอยู่ในตัวเก็บประจุในเวลาใด ๆ จะได้ว่า

$$\ln q = -\frac{t}{RC} + \text{const.} \quad (2.10)$$

เมื่อ $t = 0$ และ $q = q_0$ แทนค่าในสมการ (2.10) หาค่า const. ได้แล้ว

เอาค่า const. แทนในสมการ (2.10) จะได้

$$q = q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (2.11)$$

จำนวนตัวประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุจะเป็นปริมาณกลับกับเวลา เมื่อ $t = \infty$ ตัวประจุ

$q = 0$ จากสมการ (2.11) คำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรในเวลาใด ๆ ได้คือ

$$i = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (2.12)$$

จากสมการ (2.12) กระแสไฟฟ้ามีเครื่องหมายลบ แสดงว่าทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลตรงข้ามกับ
ครั้งแรก และเมื่อ $t = 0$ กระแสไฟฟ้าในวงจรเท่ากับ $-\frac{E}{R}$

เมื่อทราบค่าประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ และกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะคำนวณหาค่าความต่างศักดา
ไฟฟ้าที่ความต้านทาน R และที่ตัวเก็บประจุ C ได้ดังนี้

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง a

$$V_C = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (2.13)$$

$$V_R = E e^{-\frac{t}{RC}} \quad (2.14)$$

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง b

$$V_C = E e^{-\frac{t}{RC}} \quad (2.15)$$

$$V_R = -E e^{-\frac{t}{RC}} \quad (2.16)$$

จากสมการ (2.13) แสดงว่าค่าความต่างศักดาไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุ จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลา เมื่อ
ค่าแรงดัน E มีค่าคงที่ และสมการ (2.15) แสดงว่า จากการคายประจุของตัวเก็บประจุ ทำให้

ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุจะลดลงอย่างไม่เป็นเชิงเส้น

5. วงจรขยายสัญญาณความแตกต่าง

วงจรขยายสัญญาณความแตกต่าง (4,5) ดังแสดงในรูป 2.4 ลักษณะที่สำคัญของวงจร คือการป้อนอินพุตเข้ามาทั้งขั้วอินเวอร์ตติ้งอินพุต (inverting input) และนอนอินเวอร์ตติ้งอินพุต (non-inverting input) ในการวิเคราะห์ห้วงจร สัมมุติให้มีเพียงอินพุตเดียว คือ V_{i2} โดยที่ V_{i1} เป็นศูนย์เอาท์พุทที่ได้จะมีค่าเป็น

$$V_{O2} = -\frac{R_2}{R_1} V_{i2} \quad (2.17)$$

ในทำนองเดียวกันสัมมุติมีอินพุต V_{i1} แต่เพียงอย่างเดียว โดยที่ V_{i2} สัดวงจรจะพบว่าวงจรขยายจะเป็นวงจรขยายชนิดนอนอินเวอร์ตติ้ง หรือชนิดไม่กลับเฟส (phase) สัญญาณอินพุตที่เข้าที่ขั้วนอนอินเวอร์ต คือ $\frac{R_4}{R_3 + R_4} (V_{i1})$ ดังนั้นเอาท์พุทที่ปรากฏจะมีค่าเป็น

$$V_{O1} = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) V_{i1} \quad (2.18)$$

ผลรวมของเอาท์พุทคือ

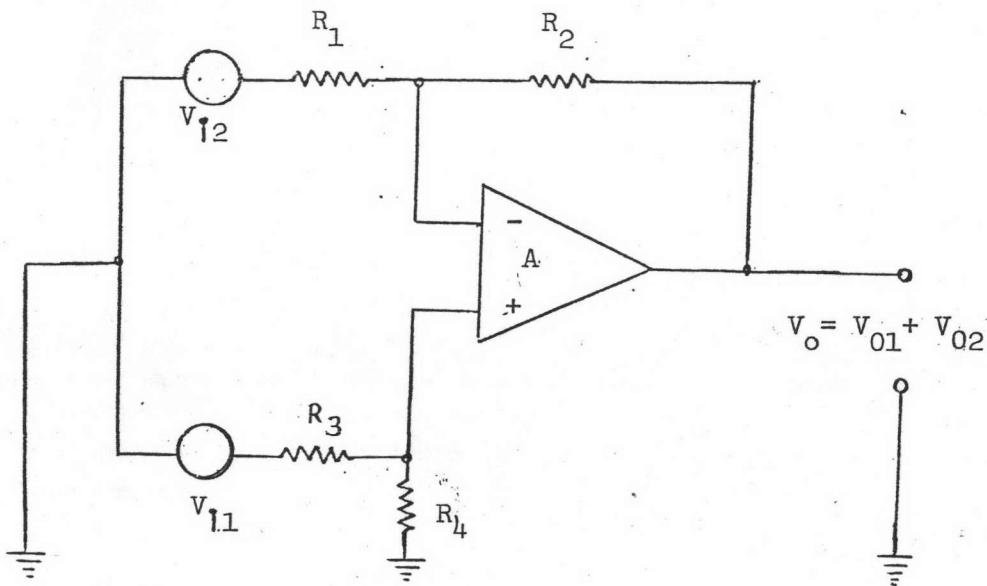
$$V_o = V_{O1} + V_{O2} \quad (2.19)$$

จากสมการ (2.17) และ (2.18) แทนลงในสมการ (2.19) จะได้ว่า

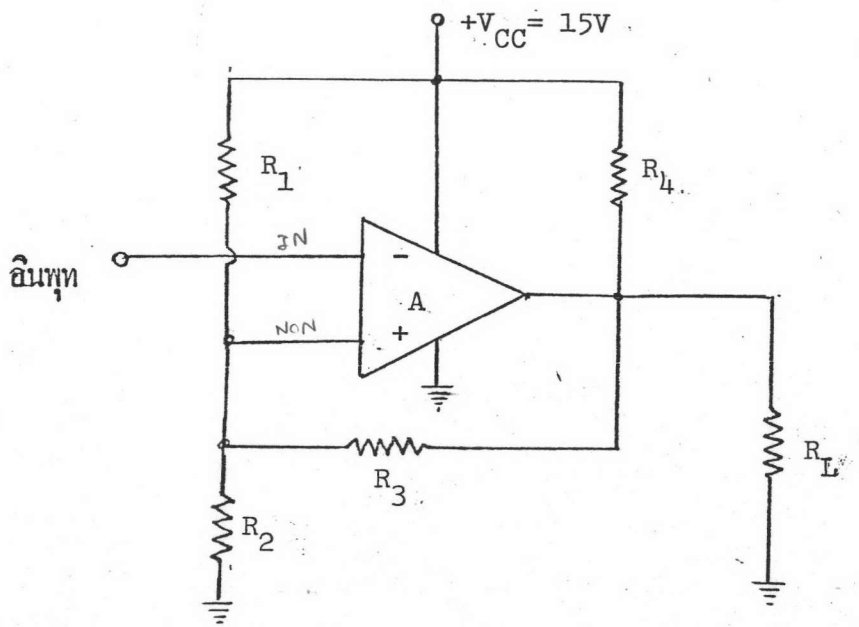
$$V_o = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) V_{i1} - \frac{R_2}{R_1} V_{i2} \quad (2.20)$$

จากสมการ (2.20) ในกรณีที่ $R_1 = R_3$ และ $R_2 = R_4$ จะได้ว่า

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_{i1} - V_{i2}) \quad (2.21)$$



รูปที่ 2.4 แสดงภาพวงจรขยายสัญญาณความแตกต่าง



รูปที่ 2.5 ก. แสดงภาพวงจร เปรียบเทียบระดับแรงดันที่ให้อิสเทอร์เรซิส

สมการ (2.21) แสดงว่า สัญญาณเอาต์พุตที่ได้จะเป็นผลจากการขยายสัญญาณผลต่างของอินพุตทั้งสอง เมื่อตัวต้านทาน R_1 และ R_2 มีค่าคงที่

6. วงจรเปรียบเทียบระดับแรงดัน

วงจรเปรียบเทียบใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล (4,5) ดังรูปที่

2.5 ก. ตัวต้านทาน R_4 ต้องเลือกให้มีค่ามากพอเพื่อจำกัดกระแสไหลเข้าไปในตัวไอซี (I.C.) มากเกินไปในขณะที่เอาต์พุตอยู่สถานะต่ำ ตัวต้านทาน R_1 และ R_2 ทำหน้าที่แบ่งแรงดัน $+V_{CC}$ เพื่อเป็นแรงดันอ้างอิง ป้อนเข้าที่อินพุตทางด้าน นอนอินเวอร์ต เพื่อให้สัญญาณที่เข้ามา เปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิงนี้

$$V_i > V_{cc}$$

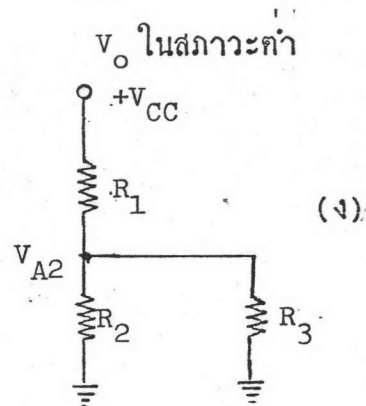
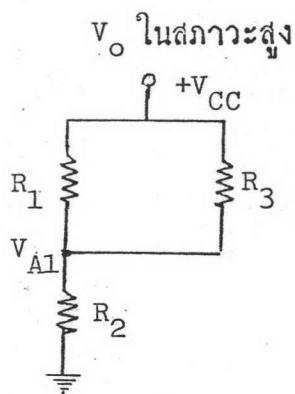
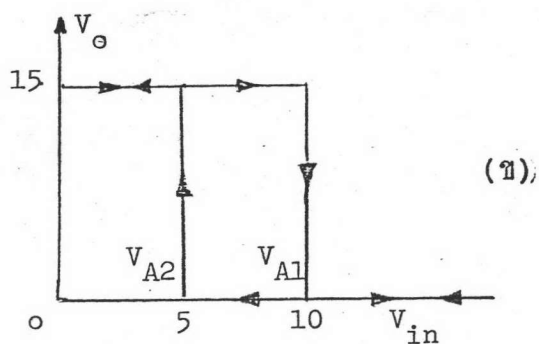
การทำงานของวงจรถ้าแรงดันอินพุตมีค่ามากกว่าแรงดันอ้างอิง ซึ่งจะทำให้อินพุตขับ (drive) เอาต์พุตมาอยู่ที่แรงดันกราวด์ และจะทำให้แรงดันอินพุตที่ขานอนอินเวอร์ตมีค่าลดลงโดยผ่านทางตัวต้านทาน R_3 ซึ่งจะทำให้เอาต์พุตยังอยู่ที่จุดอิ่มตัวที่กราวด์ยิ่งขึ้น และการป้อนกลับเข้ามา เสริมนี้จะเป็นผลทำให้เอาต์พุตยิ่งลดค่าแรงดันหรือมีช่วงเวลาการเปลี่ยนสถานะลอจิก (logic) เร็วยิ่งขึ้น (แม้ว่าอินพุตทางขาอินเวอร์ตจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม) และมีแรงดันอินพุตค่อย ๆ ลดลง มาต่ำกว่าค่าแรงดันอ้างอิง เอาต์พุตจะแกว่งขึ้นทางแรงดัน $+V_{CC}$ ก็ยิ่งทำให้แรงดันที่นอนอินเวอร์ต สูงขึ้น ทำให้การเปลี่ยนสถานะลอจิกเพิ่มความเร็วยิ่งขึ้น

จากวงจรจะเห็นได้ว่าเอาต์พุตจะเปลี่ยนสถานะเป็นฮิสเทอรีซิส (hysteresis) กับแรงดันอินพุตซึ่งสามารถออกแบบได้ด้วย ตัวต้านทานป้อนกลับ R_3 และ R_2 กับการแบ่งแรงดันอ้างอิงของ $+V_{CC}$ ด้วยตัวต้านทาน R_1 และ R_2

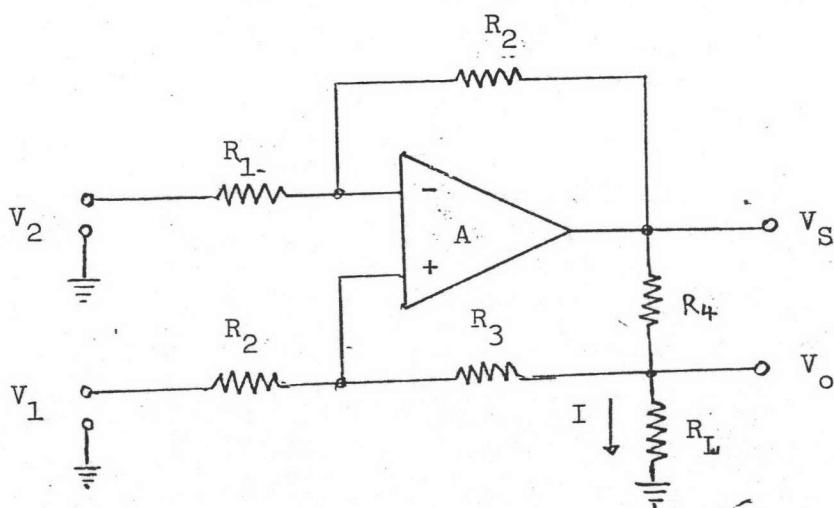
ในขณะที่เอาต์พุตอยู่ในสถานะต่ำจะเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในสถานะสูง เมื่ออินพุตมีค่าต่ำกว่าแรงดัน V_{A1} และเมื่อเอาต์พุตอยู่ในสถานะสูงจะเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในสถานะต่ำ เมื่ออินพุตเข้ามา มีค่าสูงกว่า V_{A2} ค่าฮิสเทอรีซิสแสดงดังรูปที่ 2.5 ข.

ค่าแรงดัน V_{A1} สามารถหาค่าได้ด้วยวงจรสมมูลย์ ดังรูปที่ 2.5 ค. ซึ่งจะได้ว่า

$$V_{A1} = \frac{V_{CC} R_2}{(R_1 // R_3) + R_2}$$



รูปที่ 2.5 วงจรเปรียบเทียบระดับแรงดัน (ข) ภาพแสดงการเกิดฮิสเทอรีซิส
 (ค) วงจรสมมูลย์ ขณะเอาท์พุทอยู่สภาวะสูง
 (ง) วงจรสมมูลย์ ขณะเอาท์พุทอยู่สภาวะต่ำ



รูปที่ 2.6 แสดงภาพวงจรจ่ายกระแสคงที่


นั่นคือ

$$V_{A1} = + \frac{V_{CC} R_2 (R_3 + R_1)}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \quad (2.22)$$

ในทำนองเดียวกันสามารถหาค่าแรงดัน V_{A2} ได้ จากรูปที่ 2.5 ง. จะได้ว่า

$$V_{A2} = + \frac{V_{CC} R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3}$$

นั่นคือ

$$V_{A2} = + \frac{V_{CC} R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \quad (2.23)$$


ดังนั้นสามารถหาความกว้างของฮิสเตอร์เรซิสได้จาก

$$\Delta V_A = V_{A1} - V_{A2} \quad (2.24)$$

นำสมการ (2.22) และ (2.23) แทนในสมการ (2.24) จะได้ว่า

$$\Delta V_A = + \frac{V_{CC} R_2 R_1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \quad (2.25)$$

จากสมการ (2.25) แสดงให้เห็นว่าความกว้างของฮิสเตอร์เรซิสสามารถกำหนดได้ด้วยตัวต้านทานบ่อนกสับ R_3 เมื่อให้แรงดันอ้างอิงคงที่คือ ถัดต้านทาน R_1 และ R_2 คงที่ เพื่อให้แรงดันเอาต์พุต V_O มีช่วงเปลี่ยนสถานะระหว่าง $+V_{CC}$ และกราวนด์ ควรเลือกตัวต้านทาน R_4 มีค่าน้อยกว่าความต้านทานโหลด R_L และตัวต้านทาน R_3 ต้องมีค่ามากกว่าตัวต้านทาน R_4

7. วงจรจ่ายกระแสคงที่

วงจรจ่ายกระแสคงที่อาศัยหลักการเปลี่ยนค่าแรงดันเป็นกระแส^(4,5) ดังรูปที่ 2.6

แสดงวงจรจ่ายกระแสคงที่ที่อาศัยความแตกต่างของแรงดันที่อินพุต เมื่อตัวต้านทานโหลด R_L ต่อเข้ากับกราวนด์ ที่เอาต์พุตตรง V_O จากการวิเคราะห์วงจรพบว่าแรงดันที่เอาต์พุตคือ V_S จะประกอบด้วยแรงดันที่มาจากสองส่วนคือ V_1 และ V_2 ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ของแรงดัน

เอาที่พู่กับแรงดันอินพุท ได้คือ

$$V_S = \frac{V_1 R_3 + V_0 R_1}{R_1 + R_3} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) - V_2 \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \quad (2.26)$$

และแรงดันเอาที่พู่ V_S ยังเขียนในเทอมของ

$$V_S = V_{R4} + V_0 \quad (2.27)$$

เมื่อ $V_{R4} = R_4 (I_{(R_1+R_3)} + I_L)$ (2.28)

และ $I_{(R_1+R_3)} = \frac{V_0 - V_1}{R_1 + R_3}$ (2.29)

นำสมการ (2.28) และ (2.29) แทนในสมการ (2.27) จะได้

$$V_S = R_4 \left(\frac{V_0 - V_1}{R_1 + R_3} + I_L \right) + V_0 \quad (2.30)$$

จากสมการ (2.26) กับสมการ (2.30) ต่างเท่ากับ V_S และถ้าให้ $R_2 = R_3 + R_4$ จะได้

$$I_L = \frac{R_2}{R_1 R_4} (V_1 - V_2) \quad (2.31)$$

พิจารณาสมาการ (2.31) จะเห็นว่า เมื่อตัวต้านทาน R_1 , R_2 และ R_4 คงที่ แล้ว ค่าของ กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานโหลด R_L จะมีค่าขึ้นกับผลต่างของแรงดันที่อินพุททั้งสอง ถ้าต้องการ ให้กระแส I_L มีค่าคงที่ต่อรักษาแรงดันอินพุท V_1 และ V_2 ให้คงที่ และเมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดกระแสที่ไหลผ่านโหลด R_L กระทำได้โดยปรับค่าแรงดันอินพุท V_2 หรือ V_2